

LIVE ウェビナ(日本語で実施)

あなたのGaN設計の性能を最大化するための簡単な設計のヒント

2020年12月2日 午前10時(東京時間)

発表者: 安田 昭一、日本営業部門バイス・プレジデント

ゲスト・パネリスト: Alex Lidow (アレックス・リドウ)、Ph.D.、EPCのCEO (最高経営責任者)で共同創立者

GaNの利用法
ウェビナ・シリーズ



12月2日(水)にご参加いただき、高性能電力変換回路において、GaNトランジスタを使って最大の性能を得るための基本的な手法をご覧ください。

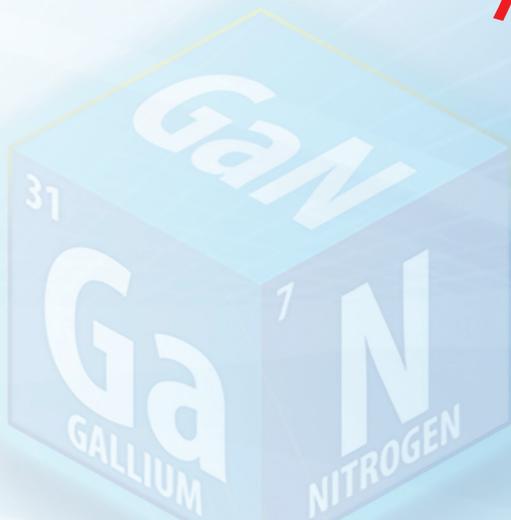
このウェビナで、安田 昭一は以下の説明をします。

- GaNの速度を最大限に活用するための最適なレイアウト手法
- 信頼性が高く、歩留りが高い結果を確実に得るためのプリント回路基板設計のヒント
- GaN設計から、さらに大きな電力を引き出すためのシンプルで安価なヒートシンク技術
- 高速スイッチング速度にもかかわらず、eGaN[®] FETは、MOSFETよりもEMI (電磁干渉) 雑音の発生が少ない理由

スペシャル・ゲスト・パネリスト: CEO のAlex Lidow (アレックス・リドウ) がウェビナ・プレゼンテーションの後のQ&Aに参加します。

すべての登録者は、書籍 *GaN Transistors for Efficient Power Conversion* の第3版のコピーを獲得するチャンスに参加できます。

今すぐ登録!



 mitsuiwa

 EPC
EFFICIENT POWER CONVERSION